

章安辉 天津 中国电子科技集团公司第四十六研究所 300192

李雨辰 天津 中国电子科技集团公司第四十六研究所 300192

摘要：本文利用扫描电子显微镜和X光电子能谱研究SiC抛光片表面氧化行为，发现Si面比C面的氧化更显著，产生更多的氧化产物，提出利用扫描电子显微镜和X光电子能谱来鉴别SiC晶片的Si面和C面的新方法。

关键词：

>文章全文为PDF格式，请下载 to 本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

### Study on the oxidation on surfaces of the polished SiC wafer by SEM,XPS

---

300192

300192

Abstract: The oxidation on surfaces of the polished SiC wafer was studied by SEM and XPS. It is found that the oxidation and the oxidation production on the silicon surface are more than those on the carbon surface. The identification of the silicon surface and carbon surface of SiC wafer using SEM or XPS was proposed.

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]